

電子線描画装置

目的 電子線リソグラフィにより、半導体、磁性材料等の表面に微細加工を行い、マイクロ・ナノメートルスケールの電子デバイス及び超高密度記録デバイスの作製に使用する。

仕様 日本電子(株)／東京テクノロジー(株)製 JSM-6500-F/Beam Draw
試料サイズ:最大約 15 mm 角、加速電圧:最大 30 kV
プローブ電流:約 1 nA(2 nm 径以下)、100 nA(8 nm 径以上)
アドレス分解能:10 nm(100 μ m 角)、2.5 nm(25 μ m 角)
描画方式:ラスタ描画方式、ベクタ描画方式

利用手順

利用希望者は、事前に装置管理者に電話で申請すること。申請内容は、利用希望日時、所属研究室、氏名。利用後は、備え付けの使用記録簿に所定の事項を記入すること。

利用上の注意

所定の講習を受け、装置動作原理を理解し、装置の取り扱いに習熟した者のみに本装置の利用を認める。装置の異常が発生した場合には速やかに装置管理者に連絡すること。

設置場所 クリーンルーム2

装置責任者 電子情報部門 尹友(TEL:1724)

連絡先(装置管理者) 電子情報部門 尹友(TEL:1724 email: yinyou@gunma-u.ac.jp)、
野口克也(TEL:1793)

